

圖 13-19 典型的井內隔離 P+in N-well 及 N+in P-well 量測結果。

#### 4.場氧化層隔離 (Field Isolation)

用來測量場氧化層上的多晶矽 (Poly) 是否因太大電場而開啟相鄰兩主動區的漏電，可利用臨界電壓及崩潰電壓的量測手法瞭解場隔離的效果，由於 0.25μm 製程以下大都採用 STI 作為主動區的隔離，場隔離能力通常沒有問題，另外也可以對第一層金屬層來檢測其對場隔離的效果。

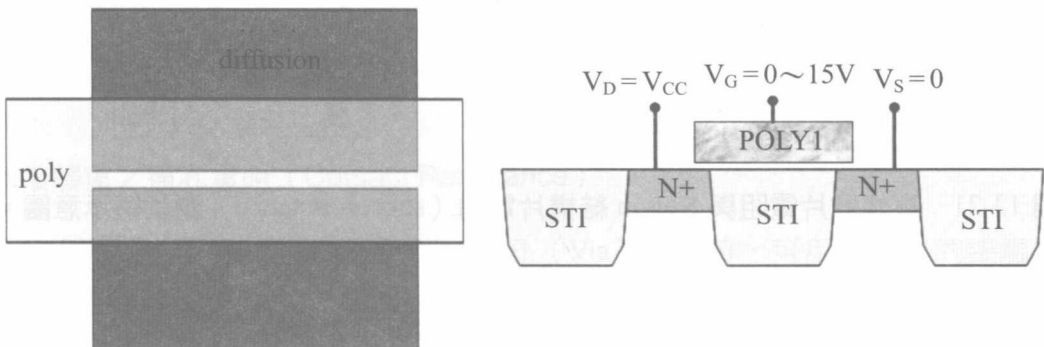


圖 13-20 典型的場隔離 (Field Isolation) 測試鍵上視圖及截面圖。

Threshold Voltage:

Measure  $I_D$  with  $V_D = V_{CC}$ ,  $V_G = 0 \sim 15V$ ,  $V_S = V_B = 0V$